



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HB123D

对应国外型号
HLB123D

主要用途

功率放大

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-45~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_C=25$)	10W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	500V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	8V
I_C ——集电极电流.....	1A

外形图及引脚排列

TO-126ML



- 1 发射极, E
- 2 集电极, C
- 3 基极, B

电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	500			V	$I_C=1mA, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	8			V	$I_E=1mA, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{CB}=500V, I_E=0$
$HFE1$	直流电流增益	10		65		$V_{CE}=5V, I_C=300mA$
$HFE2$		10				$V_{CE}=5V, I_C=500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			0.3	V	$I_C=100mA, I_B=10mA$